

PNP 三重拡散形シリコントランジスタ

高速度高耐圧スイッチング用

PNP Silicon Triple Diffused Transistor  
High Speed High Voltage Switching

特 徴

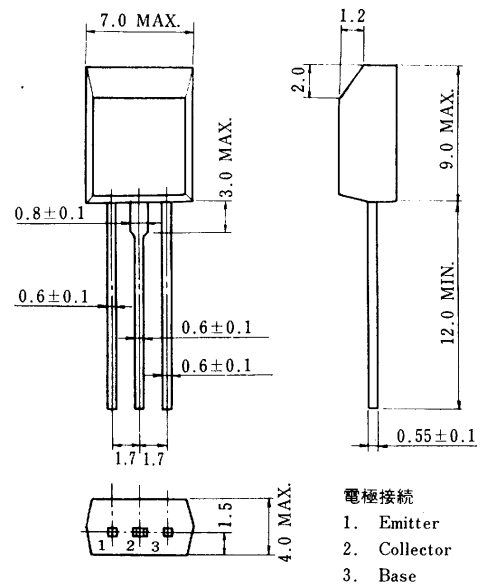
- 高耐圧です。  $V_{CE0} = -400$  V
- スイッチングスピードが速い。  $t_f < 0.7$   $\mu$ s

絶対最大定格 ( $T_a = 25$  °C)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-400	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-400	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-7	V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$	-2.0	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-4.0	A
全 損 失	$P_T$	1.0	W
ジャンクション温度	$T_j$	150	°C
保 存 温 度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	°C

\*PW ≤ 10 ms, Duty Cycle ≤ 50 %

外形図 (単位: mm)



電気的特性 ( $T_a = 25$  °C)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしや断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -400$ V, $I_E = 0$			-10	$\mu$ A
エミッタしや断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5.0$ V, $I_C = 0$			-10	$\mu$ A
直流電流増幅率	$h_{FE1}$ *	$V_{CE} = -5.0$ V, $I_C = -0.1$ A	40	60	120	—
直流電流増幅率	$h_{FE2}$ *	$V_{CE} = -5.0$ V, $I_C = -1.0$ A	6	22	—	—
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ *	$I_C = -0.5$ A, $I_B = -0.1$ A		-0.25	-0.5	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$ *	$I_C = -0.5$ A, $I_B = -0.1$ A		-0.85	-1.2	V
コレクタ容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10$ V, $I_E = 0$ , $f = 1.0$ MHz		30	40	pF
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = -10$ V, $I_C = -0.1$ A	10	40		MHz
ターンオン時間	$t_{on}$	$I_C = -1.0$ A, $R_L = 150$ $\Omega$		0.03	0.5	$\mu$ s
蓄積時間	$t_{stg}$	$I_{B1} = -I_{B2} = -0.2$ A		1.4	2.0	$\mu$ s
下降時間	$t_f$	$V_{CC} = -150$ V		0.1	0.7	$\mu$ s

\*パルス測定 PW ≤ 350  $\mu$ s, Duty Cycle ≤ 2 %

$h_{FE}$ 規格区分

捺 印	L	K
$h_{FE1}$	40 ~ 80	60 ~ 120

特性曲線 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

